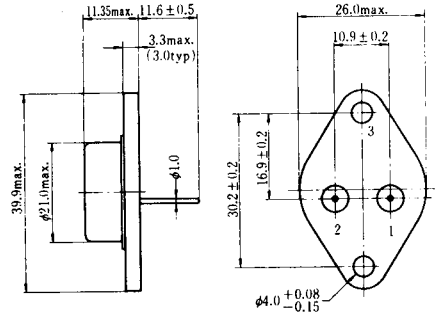
2SD764

シリコン NPN 三重拡散形

高電圧電力スイッチング用
TV 水平偏向出力用

SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED

HIGH VOLTAGE POWER SWITCHING
TV HORIZONTAL DEFLECTION OUTPUT



1. ベース：Base
2. エミッタ：Emitter
3. コレクタ：Collector
   （ケース）（Case）
   (Dimensions in mm)

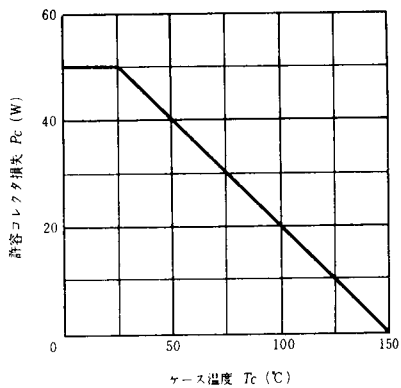
(JEDEC TO-3)

■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25℃)

項目	Symbol	2SD764	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	1500	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	600	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	6	V
コレクタ電流	I_C	1.5	A
せん頭コレクタ電流	$i_{C(peak)}$	2	A
サージコレクタ電流	$I_{C(surge)}$	5	A
許容コレクタ損失	P_C*	50	W
接合部温度	T_j	150	℃
保存温度	T_{stg}	−45～+150	℃

* T_C=25℃ における許容値
* Value at T_C=25℃

許容コレクタ損失のケース温度による変化
MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATIO
CURVE



■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25℃)

項目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$	I_C=10mA, R_{BE}=∞	600	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	I_E=10mA, I_C=0	6	—	—	V
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	V_{CB}=600V, I_E=0	—	—	10	μA
コレクタ遮断電流	I_{CBX}	V_{CB}=1500V, V_{EB}=1.5V	—	—	0.5	mA
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	I_C=1.0A, I_B=0.2A	—	—	5	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	I_C=1.0A, I_B=0.2A	—	—	1.5	V
下降時間	t_f	I_C=0.8A, I_{B1}=0.16A, I_{B2}=−0.2A	—	—	1.5	μs